

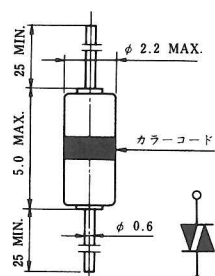
# N413

## プレーナ形シリコン双方向性トリガダイオード (DIAC)

ダイアックは三層構造からなるプレーナ形シリコン双方向性ダイオードで、ブレイクオーバー電圧以上の印加電圧に対して、双方向対称な負性抵抗を示す2端子トリガ素子です。

トライアックまたはSCRによる交流制御回路のゲートトリガに用いれば回路の簡略化、部品の節減、簡便でしかも安価な連続位相制御回路を構成することができます。

外形図 (単位:mm)



### 最大定格

項目	略号	定格	単位	条件
せん頭電流	$I_P$	$\pm 2$	A	パルス幅10 $\mu$ s 繰り返し周波数120 Hz
保存温度	$T_{stg}$	$-40 \sim +125$	$^{\circ}$ C	
接合温度	$T_j$	125	$^{\circ}$ C	

### 電気的特性 ( $T_a=25^{\circ}$ C)

項目	略号	規格			単位	備考
		最小	標準	最大		
ブレイクオーバー電圧	$V_{BO1}(V_{BO2})$	26	—	40	V	(注1)
ブレイクオーバー電圧偏差	$\Delta V_{BO}   V_{BO1} - V_{BO2}  $	—	—	3	V	(注1)
ブレイクオーバー電流	$I_{BO1}(I_{BO2})$	—	—	50	$\mu$ A	(注1)
ブレイクオーバー電圧温度係数		—	—	—	$\%/^{\circ}$ C	図1参照
せん頭出力電圧	$V_P$	5	—	—	V	(注2) 図2, 図3参照

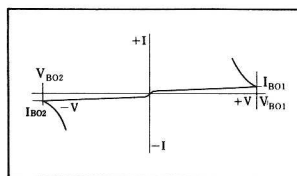
### ブレイクオーバー電圧( $V_{BO}$ )細区分

細区分規格 (カラーコード)	$V_{BO}$ (V)
L (赤)	26 ~ 32
M (青)	29 ~ 37
N (黄)	34 ~ 40

N413のブレイクオーバー電圧は表のように細分されております。

装置設計上必要な場合はご指定ください。

(注1) 基本特性



(注2) 基本特性

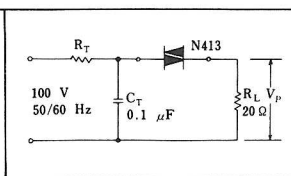


図1  $V_{BO}-T_a$  変化率特性

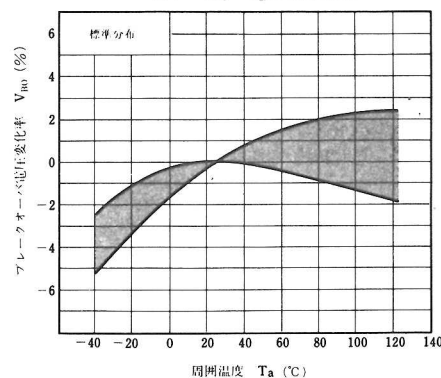


図2  $V_P-T_a$  特性

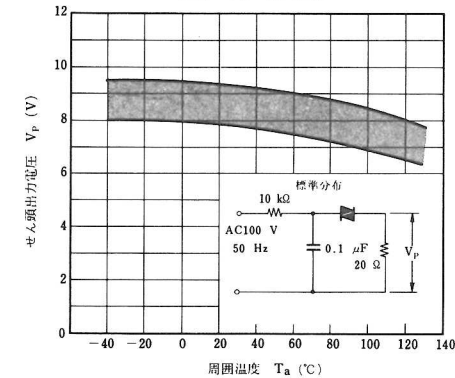


図3  $V_P-C_T$  特性

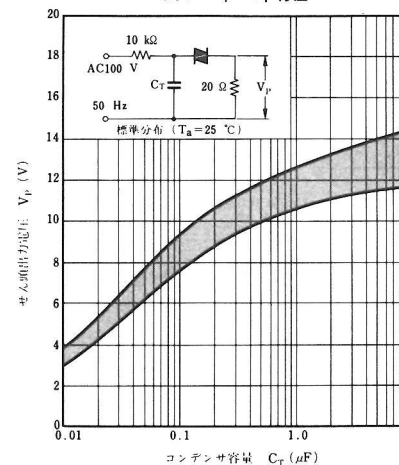


図4  $V_P-R_L$  特性

